

锗衬底晶片

锗单晶片是重要的半导体衬底材料，有着良好的半导体性质，如电子迁移率、空穴迁移率等等。主要用于地面聚光光伏电站(CPV)、空间太阳能电池板以及超高亮度的 LED 衬底材料。

先导可提供低位错或零位错锗衬底，规格包括 2 英寸、3 英寸、4 英寸和 6 英寸。亦可根据客户需求，定制非标厚度和晶向的 Ge 衬底。

单位		半导体型 规格	
晶体生长方式		CZ / VGF	
导电类型		n型	p型
掺杂		Sb	Ga
尺寸	inch	2", 3", 4" and 6"	2", 3", 4" and 6"
晶向*		(100) $\pm 0.5^\circ$	(100) $\pm 0.5^\circ$
OF/IF		US, EJ	US, EJ
电阻率（室温）	ohm. cm	0.002-40	0.002-0.005
位错密度（EPD）	/cm ²	-	0
激光打标		按客户要求定制	
成品厚度*	μm	(175-500) ± 25	
TTV平整度	μm	≤ 15	≤ 15
翘曲度	μm	≤ 25	≤ 25
主面/背面	Side1 Side2	抛光 腐蚀/研磨	抛光 腐蚀/研磨
开盒即用		是	
包装		单片盒或多片盒	

*晶向、厚度可按客户要求定制



广东先导微电子科技有限公司

高纯材料生产基地：广东省清远市高新区创兴三路16号

电话：0763-3993123 传真：(86) 020 - 83511907

邮箱：semi_sales@vitalchem.com

邮编：511517

网站：www.vitalchem.com